

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SU

Mã hồ sơ:



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: **ĐÀO VĨNH ÁI**

2. Ngày tháng năm sinh: 20/10/1977; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định.

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 57/4N1, Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

6. Địa chỉ liên hệ: 1D đường TL29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại nhà riêng: 0971861250; Điện thoại di động: 0971861250;

E-mail: daovinhai@duytan.edu.vn.

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm 02/2000 đến năm 08/2002: Giám sát Sản xuất, Phân xưởng dệt nước, Công ty Dệt may Hualon Việt Nam;

Từ năm 09/2002 đến năm 04/2003: Kỹ sư cải tiến công đoạn, Phân xưởng cáp đồng trục, Công ty Nissei Electric Vietnam;

Từ năm 10/2003 đến năm 02/2007: Trợ giảng, Bộ môn Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh;

Từ năm 09/2011 đến năm 06/2016: Giáo sư nghiên cứu, Phòng thí nghiệm Linh kiện Thông tin và Truyền thông, Khoa Kỹ thuật Điện-Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông, Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc;

Từ năm 07/2016 đến năm 06/2018: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Vật liệu, Khoa Khoa học Ứng Dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;

Từ năm 07/2018 đến nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng Dụng, Trường Đại học Duy Tân.

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng thí nghiệm FM&D (Future Materials & Devices Lab.);
Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng phòng thí nghiệm;

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng, Trường Đại học Duy Tân.

Địa chỉ cơ quan: 06 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại cơ quan: 0283 6018 456

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học: Bộ môn Công nghệ Vật liệu và Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

8. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 15 tháng 09 năm 1999; số văn bằng: B151906; ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý ứng dụng; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Được cấp bằng ThS ngày 10 tháng 05 năm 2005; số văn bằng: 00349/71KH2; ngành: Vật lý; chuyên ngành: Vật lý Điện tử; Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Được cấp bằng TS ngày 25 tháng 08 năm 2011; số văn bằng: SKKU 2010(D) 343; ngành: Kỹ thuật Điện tử và Máy tính; chuyên ngành: Vật liệu và Linh kiện điện tử; Nơi cấp bằng TS: Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc

9. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Duy Tân.

10. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý.

11. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Cơ chế truyền dẫn hạt tải trong các loại pin mặt trời dị thể trên nền Silíc;
- Phát triển cấu trúc mới cho lớp emitter trong pin mặt trời dị thể a-Si:H/c-Si;
- Ứng dụng phép xấp xỉ thống kê trong việc tối ưu hóa màng bán dẫn điện trong suốt trong pin mặt trời;
- Phát triển pin mặt trời có cấu trúc tandem;
- Pin mặt trời màng mỏng truyền suốt.

12. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 01 đề tài NCKH cấp nhà nước (Quyển phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Nafosted);
- Đã công bố 61 bài báo khoa học, trong đó 55 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

13. Khen thưởng:

- Giải ba: Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 1999, cấp Bộ Giáo dục và đào tạo;
- Giải khuyến khích: Giải thưởng khoa học sinh viên EUREKA lần thứ nhất năm học 1998-1999.

14. Kỷ luật: Không có.

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: Có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo, theo Luật Giáo dục Đại học, luôn luôn rèn luyện phẩm chất và đạo đức của một nhà giáo, không ngừng học tập nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sống trung thực, có trách nhiệm, khiêm tốn, hòa đồng và giúp đỡ đồng nghiệp trong các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học và công nghệ. Sống cống hiến và truyền nhiệt huyết đến các thế hệ học trò. Nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 06 năm 0 tháng
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ:

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2016-2017					63.00		63.00/63.00/270
2	2017-2018					326.59		326.59/326.59/270
3	2018-2019					150.20		150.20/150.20/135
03 năm học cuối								
4	2019-2020				03	256.35		256.35/286.35/135
5	2020-2021					248.51		248.51/248.51/135
6	2021-2022					240.68		240.68/240.68/135

3. Ngoại ngữ:

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài:

- Học ĐH ; Tại nước:; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; tại nước: Hàn Quốc năm 2011
- b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng:; năm cấp:.....
- c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Nơi giảng dạy: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam.
- d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Không

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Trương Doãn Việt		X	X		từ 12/2017 đến 05/2020	ĐH KHTN, ĐH QG TPHCM	19/07/2021
2	Ngô Thị Thanh Giang		X	X		từ 12/2017 đến 05/2020	ĐH KHTN TPHCM, ĐH QG TPHCM	26/04/2022

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: Không có

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)/Xếp loại KQ
I	Trước khi được công nhận TS				
1					
2					
...					
II	Sau khi được công nhận TS				
1	ĐT: Pin mặt trời dị thể Silicon với kim loại chuyển tiếp đóng vai trò trích xuất hạt tải lỗ trống: Cơ chế truyền dẫn hạt tải	CN	Mã số: 103.02-2017.43 Cấp quản lý: Nhà nước	03/2018 – 03/2021	Biên bản nghiệm thu ngày 25/01/2021, xếp loại: đạt

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
I	Trước khi được công nhận TS							
1	Hệ magnetron phẳng cân bằng ở áp suất thấp và ứng dụng nó để kim loại hóa Compact-disks (CDs)	03	C	Science and Technology Development Journal (STDJ), Vietnam National University – Ho Chi Minh City (ISSN: 1859-0128)	Tạp chí trong nước		2, 8-1999, 37-44	1999
2	Hoàn thiện quy trình tạo màng ZnO:Al với kích thước lớn	05	K	Science and Technology Development Journal (STDJ), Vietnam National University – Ho Chi Minh City (ISSN: 1859-0128)	Tạp chí trong nước		8, 3-2005, 29-34	2005
3	Chế tạo máy chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời với màng gương nóng truyền qua ZnO:Al	04	K	Science and Technology Development Journal (STDJ), Vietnam National University – Ho Chi Minh City (ISSN: 1859-0128)	Tạp chí trong nước		8, 4/2005, 28-33	2005
4	Effect of defect densities and band offsets on carrier transport mechanism in mixed phase silicon/crystalline silicon heterojunction	06	C	Journal of the Korean Physical Society (ISSN: 1976-8524)	ISI (SCI, IF = 0.649, Q4)	0	53, 2, 704-708	8, 2008
5	Electrical and optical studies of transparent conducting ZnO: Al thin films by magnetron dc sputtering	09	C	Journal of electroceramics (ISSN: 1385-3449)	ISI (SCI, IF = 1.785, Q3)	12	23, 2, 356-360	3, 2008

6	Hydrogenated Amorphous Silicon Layer Formation by Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition and Its Application for Surface Passivation of p-Type Crystalline Silicon	06	C	Japanese Journal of Applied Physics (ISSN: 0021-4922)	ISI (SCI, IF = 1.480, Q2)	9	48,6R, 066509	6, 2009
7	Effect of N ₂ O/SiH ₄ flow ratios on properties of amorphous silicon oxide thin films deposited by inductively-coupled plasma chemical vapor deposition with application to silicon surface passivation	07	C	Vacuum (ISSN: 0042-207X)	ISI (SCI, IF = 3.627, Q1)	12	84, 3, 410-414	11, 2009
8	Fabrication of polycrystalline silicon thin films on glass substrates using fiber laser crystallization	10	C	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	ISI (SCI, IF = 2.183, Q2)	06	517, 14, 3971-3974	5, 2009
9	Selective emitter using porous silicon for crystalline silicon solar cells	12	K	Solar Energy Materials & Solar Cells (ISSN: 0927-0248)	ISI (SCI, IF = 7.267, Q1)	17	93, 6-7, 846-850	2009
10	rf-Magnetron sputtered ITO thin films for improved heterojunction solar cell applications	09	C	Current Applied Physics (ISSN: 1567-1739)	ISI (SCI, IF = 2.480, Q2)	60	10, 3, 506-509	5, 2010
11	Optimized surface passivation of n and p type silicon wafers using hydrogenated SiN _x layers	06	C	Journal of Non-Crystalline Solids (ISSN: 0022-3093)	ISI (SCI, IF = 3.531, Q1)	10	356, 50-51, 2880-2883	11, 2010
12	Simulation and study of the influence of the buffer intrinsic layer, back-surface field, densities of interface	08	C	Solar Energy (0038-092X)	ISI (SCI, IF = 5.742, Q1)	97	84, 5, 777-783	5, 2010

	defects, resistivity of p-type silicon substrate and transparent conductive oxide on heterojunction with intrinsic thin-layer (HIT) solar cell							
13	Interface Characterization and Electrical Transport Mechanisms in a-Si:H/c-Si Heterojunction Solar Cells	06	C	Journal of The Electrochemical Society (ISSN:0013-4651)	ISI (SCI, IF 4.136, Q1)	33	158, 3,312	1, 2011
14	The mechanisms of negative oxygen ion formation from Al-doped ZnO target and the improvements in electrical and optical properties of thin films using off-axis dc magnetron sputtering at low temperature	08	C	Semiconductor Science and Technology (ISSN: 0268-1242)	ISI (SCI, IF = 2.352, Q2)	18	26, 10, 105022	8, 2011
II	Sau khi được công nhận TS							
15	Effect of Valence Band Offset and Surface Passivation Quality in the Silicon Heterojunction Solar Cells	08	C	Journal of The Electrochemical Society (ISSN:0013-4651)	ISI (SCI, IF 4.136, Q1)	13	158,11,1129	10, 2011
16	Operation mechanism of Schottky barrier nonvolatile memory with high conductivity InGaZnO active layer	09	K	Applied Physics Letters (ISSN: 0003-6951)	ISI (SCI, IF = 3.791, Q1)	20	100, 14, 143502	4, 2012
17	The Compromise Condition for High Performance of the Single Silicon Heterojunction Solar Cells	08	K	International Journal of Photoenergy (ISSN: 1110-662X)	ISI (SCIE, IF = 2.113, Q3)	0	2012, 283872	2012
18	Ultrathin oxide passivation layer by rapid thermal oxidation for the silicon heterojunction	05	K	International Journal of Photoenergy (ISSN: 1110-662X)	ISI (SCIE, IF = 2.113, Q3)	25	2012, 753456	2012

	solar cell applications							
19	Low defect interface study of intrinsic layer for c-Si surface passivation in a-Si:H/c-Si heterojunction solar cells	09	K	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	ISI (SCI, IF = 2.183, Q2)	28	521, 45-49	10, 2012
20	Trapping time characteristics of carriers in a-InGaZnO thin-film transistors fabricated at low temperatures for next-generation displays	05	C	Journal of electronic materials (ISSN: 0361-5235)	ISI (SCI, IF = 1.938, Q2)	08	42, 4, 711-715	12, 2012
21	Effects of LiF/Al back electrode on the amorphous/crystalline silicon heterojunction solar cells	12	K	Materials Science and Engineering: B (ISSN: 0921-5107)	ISI (SCI, IF: 4.051, Q2)	24	178, 9, 660-664	11, 2012
22	A study of tunnel recombination junction on a-Si:H/HIT tandem structure solar cell	06	K	2013 IEEE 39th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), Tampa, FL, USA, 16-21 June 2013 (ISSN: 0160-8371)	Conference Record of the IEEE Photovoltaic Specialists Conference (năm trong hệ thống Scopus và Scimago)	3	1361-1363	6, 2013
23	Bias-stress-induced threshold voltage shift dependence of negative charge trapping in the amorphous indium tin zinc oxide thin-film transistors	08	K	Semiconductor Science and Technology (ISSN: 0268-1242)	ISI (SCI, IF = 2.352, Q2)	18	28, 10, 105014	8, 2013
24	Processed optimization for excellent interface passivation quality of amorphous/crystalline silicon solar cells	07	K	Solar Energy Materials & Solar Cells (ISSN: 0927-0248)	ISI (SCI, IF = 7.267, Q1)	22	117, 174-177	10, 2013
25	Interfacial barrier height modification of indium tin oxide/a-Si: H (p) via control	13	K	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	ISI (SCI, IF = 2.183, Q2)	14	546, 342-346	11, 2013

	of density of interstitial oxygen for silicon heterojunction solar cell application							
26	A buffer-layer/a-SiO _x : H (p) window-layer optimization for thin film amorphous silicon based solar cells	08	K	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	ISI (SCI, IF = 2.183, Q2)	28	546, 331-336	11, 2013
27	A statistical approach for the optimization of indium tin oxide films used as a front contact in amorphous/crystalline silicon heterojunction solar cells	09	C	Energy conversion and management (ISSN: 0196-8904)	ISI (SCIE, IF = 9.709, Q1)	12	87, 191-198	11, 2014
28	Improvement of haze ratio of DC (direct current)-sputtered ZnO: Al thin films through HF (hydrofluoric acid) vapor texturing	10	K	Energy (ISSN: 0360-5442)	ISI (SCI, IF = 7.147, Q1)	14	66, 20-24	3, 2014
29	Improved hydrogen capping effect in n-type crystalline silicon solar cells by SiN (Si-Rich)/SiN (N-rich) stacked passivation	10	K	Journal of electronic materials (ISSN: 0361-5235)	ISI (SCI, IF = 1.938, Q2)	02	43, 9, 3191-3195	9, 2014
30	The effects of orientation changes in indium tin oxide films on performance of crystalline silicon solar cell with shallow-emitter	10	C	Materials Letters (ISSN: 0167577X)	ISI (SCI, IF = 3.423, Q 2)	06	132, 322-362	10, 2014
31	Effect of high conductivity amorphous InGaZnO active layer on the field effect mobility improvement of thin film transistors	04	K	Journal of Applied Physics (ISSN: 0021-8979)	ISI (SCI, IF = 2.546, Q2)	15	116, 21, 214504	12, 2014
32	Performance of hetero junction with intrinsic thin-layer	08	K	Journal of Photonics for Energy (ISSN:	ISI (SCIE, IF = 1.836, Q3)	09	4, 1, 043094	5, 2014

	solar cell depending upon contact resistivity of front electrode			1947-7988)				
33	Role of double ITO/In ₂ O ₃ layer for high efficiency amorphous/crystalline silicon heterojunction solar cells	11	K	Materials Research Bulletin (ISSN: 0025-5408)	ISI (SCI, IF = 4.641, Q1)	21	58, 83-87	10, 2014
34	Effective optimization of indium tin oxide films by a statistical approach for shallow emitter based crystalline silicon solar cell applications	10	K	Solar Energy Materials & Solar Cells (ISSN: 0927-0248)	ISI (SCI, IF = 7.267, Q1)	16	125, 176-183	6, 2014
35	Free-carrier absorption and Burstein–Moss shift effect on quantum efficiency in heterojunction silicon solar cells	10	C	Vacuum (ISSN: 0042-207X)	ISI (SCI, IF = 3.627, Q1)	12	108, 39-44	10, 2014
36	In and Ga codoped ZnO film as a front electrode for thin film silicon solar cells	08	K	Advances in Condensed Matter Physics (ISSN: 1687-8108)	ISI (SCIE, IF = 1.845, Q4)	25	2014, 971528	1, 2014
37	Study of stacked-emitter layer for high efficiency amorphous/crystalline silicon heterojunction solar cells	09	C	Journal of Applied Physics (ISSN: 0021-8979)	ISI (SCI, IF = 2.546, Q2)	15	116, 24, 244506	2014
38	High-efficiency silicon solar cells: A review	05	C	Israel Journal of Chemistry (0021-2148)	ISI (SCI, IF = 3.333, Q1)	59	55., 10, 1050-1063	10, 2015
39	n-type hydrogenated microcrystalline silicon/indium tin oxide back-reflector interfacial characterization for micromorph tandem solar cell applications	06	C	Journal of Renewable and Sustainable Energy (ISSN: 1941-7012)	ISI (SCIE, IF = 2.219, Q3)	0	7, 3, 033112	2015
40	Source/drain	07	C	Materials	ISI (SCI, IF =	14	39, 649-653	11,

	metallization effects on the specific contact resistance of indium tin zinc oxide thin film transistors			Science in Semiconductor Processing (ISSN: 1369-8001)	3.927, Q2)			2015
41	Role of Schottky barrier height at source/drain contact for electrical improvement in high carrier concentration amorphous InGaZnO thin film transistors	05	C	Materials Science in Semiconductor Processing (ISSN: 1369-8001)	ISI (SCI, IF = 3.927, Q2)	13	38, 50-56	10, 2015
42	Effect of thermal annealing on the optical and electrical properties of boron doped a-SiO _x :H for thin-film silicon solar cell applications	09	K	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	ISI (SCI, IF = 2.183, Q2)	13	587, 132-136	2015
43	Improvement in front-contact resistance and interface passivation of heterojunction amorphous/crystalline silicon solar cell by hydrogen-diluted stacked emitter	09	C	IEEE Journal of Photovoltaics (ISSN: 2156-3381)	ISI (SCIE, IF = 3.889, Q1)	16	9, 4, 837-845	5, 2016
44	Role of SiO _x N _y surface passivation layer on stability improvement and kink effect reduction of ELA poly silicon thin film transistors	04	C	Microelectronic Engineering (ISSN: 0167-9317)	ISI (SCI, IF = 2.523, Q2)	03	164, 14-19	10, 2016
45	Current transport studies of amorphous n/p junctions and its application in a-Si:H/HIT-type tandem cells	05	C	Progress in Photovoltaics: Research and Applications (ISSN: 1062-7995)	ISI (SCI, IF = 7.953, Q1)	20	24, 1, 52-58	1, 2016
46	Al ₂ O ₃ /SiON stack layers for effective surface passivation and anti-reflection of high efficiency n-type c-Si solar cells	10	C	Semiconductor Science and Technology (ISSN: 0268-1242)	ISI (SCI, IF = 2.352, Q2)	10	32, 2, 025005	1, 2017
47	High efficiency	08	C	Scientific	ISI (SCI, IF =	12	8, 1, 1-11	10,

	inorganic/inorganic amorphous silicon/heterojunction silicon tandem solar cells			reports (ISSN: 2045-2322)	4.380, Q1)			2018
48	The effect of band gap of a-SiGe:H intrinsic layer in heterojunction Silicon solar cells	05	C	Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Đại học Duy Tân (ISSN: 1859 - 4905)	Tạp chí trong nước		4, 35, 58-63	2019
49	The effects of refractive index and defects in silicon oxide films on the passivation qualities in c-Si solar cells	09	C	Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Đại học Duy Tân (ISSN: 1859 - 4905)	Tạp chí trong nước		4, 35, 80-85	2019
50	<i>In Situ</i> Process to Form Passivated Tunneling Oxides for Front-Surface Field in Rear-Emitter Silicon Heterojunction Solar Cells	09	C	ACS Sustainable Chemistry & Engineering (ISSN: 2168-0485)	ISI (SCIE, IF = 8.198, Q1)	01	7, 24, 19332-19337	11, 2019
51	Damage to passivation contact in silicon heterojunction solar cells by ITO sputtering under various plasma excitation modes	09	C	Solar Energy Materials & Solar Cells (ISSN: 0927-0248)	ISI (SCI, IF = 7.267, Q1)	26	192, 36-45	4, 2019
52	The recorded open-circuit voltage and fill factor achievement of a-Si:H pi-n/HIT-type tandem solar cells by tuning up the crystalline in tunneling recombination junction layer	10	C	Semiconductor Science and Technology (ISSN: 0268-1242)	ISI (SCI, IF = 2.352, Q2)	04	34, 065004	3, 2019
53	Improvement of the storage ability of Si-rich oxide layer in poly-Si based nonvolatile memory devices by implementation of taguchi method	07	C	Semiconductor Science and Technology (ISSN: 0268-1242)	ISI (SCI, IF = 2.352, Q2)	0	34, 9, 095020	8, 2019

54	Effects of oxidation state on photovoltaic properties of reactively magnetron sputtered hole-selective WO _x contacts in silicon heterojunction solar cells	09	C	Semiconductor Science and Technology (ISSN: 0268-1242)	ISI (SCI, IF = 2.352, Q2)	03	35, 4, 045020	3, 2020
55	Carrier transport mechanisms of reactively direct current magnetron sputtered tungsten oxide/n-type crystalline silicon heterojunction	10	C	Journal of Power Sources (ISSN: 0378-7753)	ISI (SCI, IF = 9.127, Q1)	02	472, 228460	10, 2020
56	Transparent photovoltaic cells and self-powered photodetectors by TiO ₂ /NiO heterojunction	07	C	Journal of Power Sources (ISSN: 0378-7753)	ISI (SCI, IF = 9.127, Q1)	36	481, 228865	1, 2021
57	Transparent Stacked Photoanodes with Efficient Light Management for Solar-Driven Photoelectrochemical Cells	05	C	ACS Applied Materials & Interfaces (ISSN: 1944-8244)	ISI (SCI, IF = 9.229, Q1)	07	13, 8, 10181-10190	2, 2021
58	Over 30% efficiency bifacial 4-terminal perovskite-heterojunction silicon tandem solar cells with spectral albedo	10	C	Scientific Reports (ISSN: 20452322)	ISI (SCI, IF = 4.380, Q1)	12	11, 1, 1-10	7, 2021
59	A study on the influence of the albedo spectrum on the bifacial GaAs/c-Si heterojunction tandem solar cell using computer modelling	10	C	Solar Energy (ISSN: 0038-092X)	ISI (SCI, IF = 5.742, Q1)	0	227, 440-496	10, 2021
60	Crystalline silicon photovoltaic module degradation: Galvanic corrosion and its solution	07	K	Engineering Failure Analysis (ISSN: 13506307)	ISI (SCIE, 3.114, Q1)	0	138, 106329	8, 2022

61	Enhancement of photoconversion efficiency of CdSe quantum dots sensitized Al doped ZnO/Si heterojunction device decorated with Ag nanostructures	09	K	Materials Science in Semiconductor Processing (13698001)	ISI (SCIE, 3.927, Q2)	0	149, 106878	10, 2022
----	--	----	---	--	-----------------------	---	-------------	----------

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau TS: 25 (15, 20, 27, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59)

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không có

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.HCM , ngày 26 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÀO VĨNH ÁI